

СТИМУЛИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НА ВТОРОЙ ГАРМОНИКЕ
ЦИКЛОТРОННОГО РЕЗОНАНСА ЛЕГКИХ ДЫРОК p -Ge В $E \perp H$ ПОЛЯХ
A.В.Муравьев, Ю.Н.Ноздрин, В.Н.Шастин

Сообщается об эффекте генерации на второй гармонике циклотронного резонанса легких дырок p -Ge в скрещенных электрическом и магнитном ($E \perp H$) полях. Измерены его спектральные характеристики. Обсуждается механизм и условия наблюдения.

В последнее время большой интерес вызвали работы по источникам длинноволнового ИК стимулированного излучения (СИ) на горячих дырках p -Ge в $E \perp H$ полях (например, ¹⁻⁸). Экспериментальные исследования подтвердили ³ идею лазера на переходах между состояниями легких (l) и тяжелых (h) дырок ¹ и обнаружили эффект СИ на циклотронном резонансе (ЦР) легких дырок ^{4, 5}. Эффекты СИ на этих механизмах возникают при близких значениях электрических, но различных соотношениях электрического и магнитного полей и существенно отличаются спектральными характеристиками. Излучение лазера на $l - h$ -переходах широкополосно ($\Delta\nu \lesssim 20 \text{ см}^{-1}$) и частоты излучения $\nu = 45 \div 50; 75 \div 125 \text{ см}^{-1}$

во многом определяются распределением легких дырок. СИ на ЦР легких дырок, напротив, узкополосно ($\Delta\nu < 0,1 \text{ см}^{-1}$), частота генерации $\nu = 30 \div 50 \text{ см}^{-1}$ ⁴ и $\nu = 70 \div 85 \text{ см}^{-1}$ ⁵ определяются соотношением $\nu = \nu_l^c = eH/2\pi c^2 m_l^*$ (см⁻¹), где c – скорость света и $m_l^* = 0,046 m_0$ – масса свободного электрона.

В настоящей работе сообщается о наблюдении СИ на второй гармонике ЦР легких дырок и подтверждается влияние на излучение $l - h$ -лазера ЦР гармоник более высокого порядка⁷. Полученные результаты расширяют представления о роли квантования Ландау в эффектах СИ на горячих дырках p -Ge в $E \perp H$ полях⁵⁻⁷.

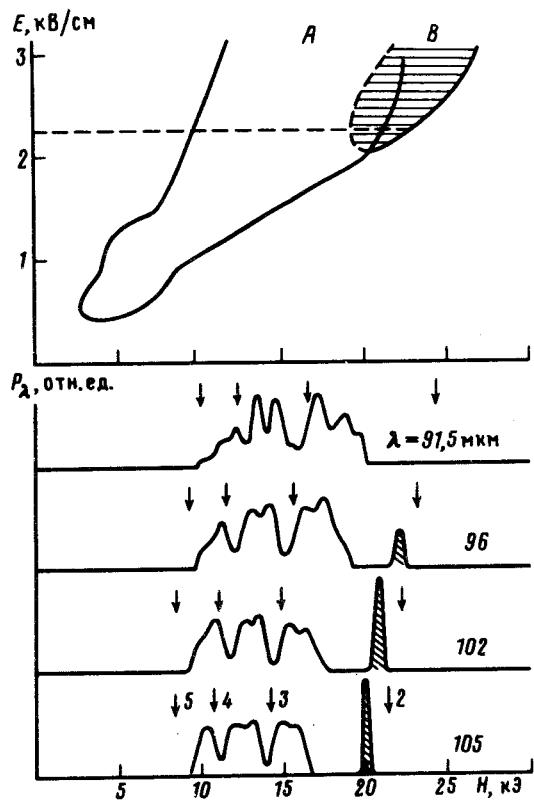


Рис. 1

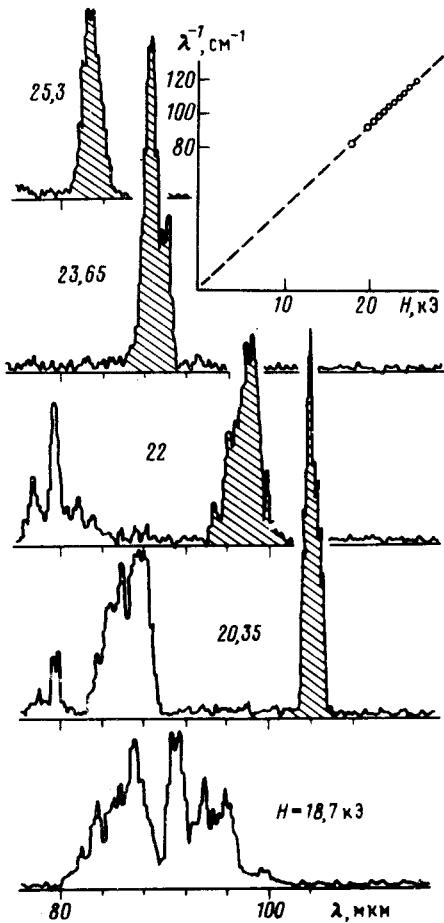


Рис. 2

Рис. 1. Зоны генерации и зависимости спектральной плотности мощности P_λ от поля H при $E \approx 2,3 \text{ кВ/см}$. Стрелки – положения резонансов $\lambda^{-1} \equiv \nu = \Delta n \cdot \nu_l^c$ при $m_l^* = 0,042 m_0$

Рис. 2. Спектры СИ $P(\lambda)$ при $E \approx 2,6 \text{ кВ/см}$, на вставке – зависимость частоты заштрихованной линии излучения от H

Эксперимент выполнялся на установке, аналогичной³. Активным элементом являлись образцы p -Ge с концентрацией дырок $p \approx (5 \div 7) \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, имевшие форму прямоугольного параллелепипеда и размеры $5 \times 7 \times 50 \text{ мм}^3$ и $4,5 \times 7,5 \times 60,0 \text{ мм}^3$. Образцы помещались в соленоид и охлаждались жидким гелием, а на боковые грани (5×50 ; $4,5 \times 60,0$) через омические контакты подавались импульсы электрического поля. Поля были ориентированы вдоль кристаллографических осей $H \parallel \langle 111 \rangle$, $E \parallel \langle 110 \rangle$. Генерация развивалась на модах полного внутреннего отражения³, а излучение регистрировалось в направлении магнитного поля. Спектральные измерения выполнялись на решеточном монохроматоре с раз-

решением до 1 см^{-1} . В области полей A (рис. 1) наблюдался известный ^{3, 6-8} эффект СИ на $l - h$ -переходах. На рис. 1 показаны зависимости спектральной плотности мощности СИ от магнитного поля $P_\lambda (H)$ для некоторых длин волн λ . Следует обратить внимание на ее ~~и~~ синхротронный характер в области A и появление обособленной резонансной по H области СИ (заштрихована) в полях $E > 2 \text{ кВ/см}$ (область B). Положения наблюдаемых особенностей в областях A и B пропорциональны λ^{-1} и не зависят от E и размеров образцов, что позволяет связать их с гармониками ЦР легких дырок. Соответствующие особенности в спектрах СИ, как сейчас ясно, наблюдались и ранее (см., например, ⁸), но из-за изрезанности спектра линиями резонатора на их связь с гармониками не было обращено внимания. На рис. 2 показана перестройка спектра СИ при изменении магнитного поля H . В зоне B в спектре появляется сравнительно узкая $\Delta v \approx 1 \div 3 \text{ см}^{-1}$ линия генерации с перестраивающейся пропорционально H частотой, соответствующей удвоенной частоте ЦР легких дырок $v \approx 2v_l^c$ при $m_l^* = (0, 040 \pm 0, 002)m_0$. Заметим, что m_l^* несколько меньше обычно используемого значения эффективной массы $m_l = 0, 042m_0$. Гармоники высших порядков ($3 \div 5$) в отличие от второй проявляются в спектрах на фоне широкополосного $l - h$ -излучения (ср. ⁷, где излучение на высших гармониках связывалось с оголением нижних уровней Ландау легких дырок в нелинейном режиме $l - h$ -генерации). Генерация же на второй гармонике вполне независима, что говорит о существовании самостоятельного связанного с ней механизма усиления. Интерпретация эффектов гармоник ЦР требует привлечения квантовых представлений о состояниях валентной зоны Ge в $E \perp H$ полях. На рис. 3 приведены

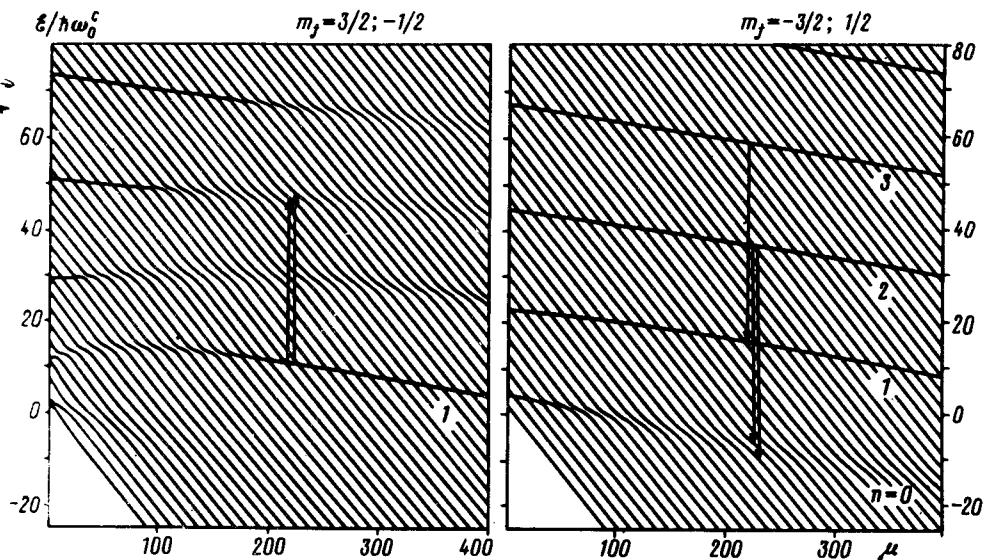


Рис. 3. Спектр полных энергий ϵ состояний дырок в $E \perp H$ полях в единицах циклотронной энергии $\hbar\omega_0^c = \hbar eH/m_0c$. Рассчитан в изотропном приближении гамильтониана Латтинжера ($\gamma_L = 13, 2; \gamma = 4, 92; k = 3, 3$), $\mu = m_0^2 c^3 E^2 / 2e \hbar H^3$ – безразмерная энергия дрейфового движения. Движение дырок вдоль H и рассеяние на оптических фонах не учитывались

результаты расчета спектра полных энергий этих состояний в зависимости от безразмерной энергии дрейфа $\mu \sim E^2 / H^3$ (ср. ⁵). Растворение уровней энергии является следствием взаимодействия и гибридизации l - и h -состояний или, другими словами, туннелирования ¹⁰. При этом деление дырок на легкие и тяжелые в областях гибридизации чисто условно и отражает лишь разную степень локализации волновых функций. Инверсия населенностей в та-

кой системе возникает из-за сильной дифференциации состояний по степени взаимодействия с оптическими фононами, которое в условиях динамического разогрева в сильных $E \perp H$ полях (зоны A и B) является основным механизмом рассеяния тяжелых дырок за время $\tau \leq 10^{-12}$ с. Нижние уровни Ландау "легких" дырок с номерами $n \leq 3$ в области B ($\mu = 150 \div 400$) и до $n \leq 7$ в области A ($\mu \geq 300$) оказываются замагничеными и слабо взаимодействуют с оптическими фононами. Их времена жизни при этом значительно больше и определяются долей "тяжелой" волновой функции (а также рассеянием на акустических фонах и заряженных примесях за $\tau \approx 10^{-11}$ с). Оптические переходы с этих состояний на нижележащие h состояния дают усиление на $l - h$ -переходах, которое качественно согласуется с квазиклассическими представлениями⁶. Кроме этого, из-за $l - h$ -гибридизации разрешены переходы между легкими состояниями с $\Delta n > 1$, которые также могут быть инвертированы из-за разной примеси тяжелой волновой функции. Это приводит к дополнительному усилению на частотах вблизи гармоник ЦР легких дырок, что подтверждается численными расчетами матричных элементов оптических переходов. Генерация на второй гармонике по нашему мнению определяется $2 \rightarrow 0$ и $3 \rightarrow 1$ переходами с квантовым числом $m_j = -3/2; 1/2$ (см. рис. 3). Стрелками вверх отмечены конкурирующие переходы, которые оказываются более длинноволновыми. Аналогично переходы типа $3 \rightarrow 0, 4 \rightarrow 0, \dots$ по мере замагничивания $3, 4, \dots$ состояний при уменьшении поля H (μ — увеличивается) складываются с усилением на $l - h$ -переходах и приводят к осцилляторной зависимости $P_\lambda(H)$ в зоне A (рис. 1). Удвоение числа резонансов можно объяснить тем, что анизотропия валентной зоны и движение дырок вдоль H должны снимать запрет для оптических переходов между "лестницами" с квантовыми числами $m_j = 3/2; -1/2$ и $m_j = -3/2; 1/2$ (рис. 3).

В заключение подчеркнем важность СИ на второй гармонике ЦР легких дырок для создания узкополосного перестраиваемого источника длинноволнового ИК излучения.

Авторы выражают благодарность А.А.Андронову полезное обсуждение результатов, а также С.А.Павлову и В.А.Козлову за сотрудничество.

Литература

1. Андронов А.А., Козлов В.А., Мазов Л.С. и др. Письма в ЖЭТФ, 1979, 30, 585.
2. Воробьев Л.Е., Осокин Ф.И., Стабеев В.И. и др. Письма в ЖЭТФ, 1982, 35, 360.
3. Андронов А.А., Зверев И.В., Козлов В.А. и др. Письма в ЖЭТФ, 1984, 40, 69.
4. Иванов Ю.Л., Васильев Ю.Б. Письма в ЖТФ, 1983, 9, 613.
5. Митягин Ю.А., Мурzin В.Н., Стоклицкий С.А., Трофимов И.Е. Письма в ЖЭТФ, 1987, 46, 116.
6. Komiyama S. Proc. of 18-th, Int. Conf. Phys. Semiconductors, Stockholm, 1986, 1641.
7. Муравьев А.В., Ноздрин Ю.Н., Шастин В.Н. Письма в ЖЭТФ, 1986, 43, 348.
8. Андронов А.А. и др. КЭ, 1987, 14, 702.
9. Wallis R.F., Bowlden H.J. Phys. Rev., 1960, 118, 456.
10. Дьяконов М.И., Перель В.И. ЖЭТФ, 1987, 92, 350.